

## 2A 150V 三极管

### N1. 4L-150V 三极管 N 管 硅 NPN 外延平面功率晶体管芯片

#### 系列信息

产品名称	封装形式
N1.4L-150V	SOT-89-3L

#### 典型应用

- \*电源调整管
- \*音频功率放大器
- \*其他电子电路

#### 电参数 (T=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	BVCBO	IC=0.1mA,IE=0	180		V
集电极-发射极击穿电压	BVCEO	IC=10mA,IB=0	150		V
发射极-基极击穿电压	BVEBO	IE=0.1mA,IC=0	6		V
集电极-基极截止电流	ICBO	VCB=144V,IE=0		1	μA
发射极-基极截止电流	IEBO	VEB=5V, IC=0		1	μA
直流电流增益	hFE	VCE=5V, IC=0.5A	60	250	
集电极-发射极饱和电压	VCES	IC=2A,IB=0.2A		1.0	V
基极-发射极饱和电压	VBES	IC=2A,IB=0.2A		1.6	V

### P1. 4L-150V 三极管 P 管 硅 PNP 外延平面功率晶体管芯片

#### 系列信息

产品名称	封装形式
P1.4L-150V	SOT-89-3L

#### 典型应用

- \*电源调整管
- \*音频功率放大器
- \*其他电子电路

#### 电参数 (T=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	BVCBO	IC=-0.1mA,IE=0	-180		V
集电极-发射极击穿电压	BVCEO	IC=-10mA,IB=0	-150		V
发射极-基极击穿电压	BVEBO	IE=-0.1mA,IC=0	-6		V
集电极-基极截止电流	ICBO	VCB= -144V,IE=0		-1	μA
发射极-基极截止电流	IEBO	VEB=-5V, IC=0		-1	μA
直流电流增益	hFE	VCE=-5V, IC=-0.5A	60	250	
集电极-发射极饱和电压	VCES	IC=-1A,IB= -0.2A		-1.0	V
基极-发射极饱和电压	VBES	IC=-1A,IB= -0.2A		-1.6	V

#### SOT-89-3L封装

